



مجله سنجش و ایمنی پرتو، جلد ۸، شمارهٔ ٤، ویژهنامه پرتوهای یونساز، ۱۳۹۹، صفحه ۳۵۷–۳۵۲ پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیریونساز (مهرماه ۱۳۹۷) تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱، تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

بررسی عمق نفوذ طیف بتای نیکل۶۳ در سیلیکون به روش مونتکارلو با بهره گیری از کد MCNPX

داود قاسم آبادی * و مسعود عبدالله زاده

گروه فیزیک، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران. *تهران، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، گروه فیزیک، کدپستی:۱۲۹۸۷۱۵٤٦۱ یستالکترونیکی: Davood.Ghasemabadi@gmail.com

چکیدہ

در این پژوهش، طیف انرژی بتای نیکل۳۳ به صورت طیف کامل انرژی، انرژی متوسط طیف و انرژی ماکزیمم طیف جهت بررسی عمق نفوذ در سیلیکون در نظر گرفته شده است. محاسبات انجام شده به روش مونتکارلو با بهرهگیری از کد MCNPX در یک هندسه مشخص انجام گردید؛ در ادامه توان توقف الکترون با انرژی مختلف در سیلیکون با استفاده از کد محاسباتی ESTAR محاسبه گردید. نتایج بدست آمده توافق خوبی باهم دارند. محاسبات انجام شده در طراحی قطعات نیمههادی آشکارسازها و دزیمترهای هستهای قابل استفاده است.

كليدواژگان: طيف انرژی بتا، نيكل ٦٣، عمق نفوذ، كد MCNPX ، كد محاسباتي ESTAR.

۱. مقدمه

دارای انرژی جنبشی T است. ولی در یک باریکه ذرات بتا با انرژی ماکزیمم Emax، متشکل از الکترونهایی است که دارای طیف انرژی پیوسته هستند که از صفرتا انرژی بیشینه Emax تغییر می کند. برای بسیاری از محاسبات ذرات بتا با یک میانگین انرژی، بهصورت یکسوم انرژی بیشینه طیف ذرات بتا در نظر گرفته می شود. تخمین دقیق تر محاسبه انرژی میانگین طیف بتا در مرجع [۱] انجام شده است. در اغلب واپاشی های بتا، هسته نهایی در حالت برانگیخته است و بنابراین پرتوهای گاما به همراه ذرات بتا گسیل می شوند. معمولترین چشمههای الکترونهای سریع، رادیو ایزوتوپهایی هستند که با گسیل بتای منفی واپاشی میکنند. این فرآیند بهصورت [−]v + ^β + ^γ + ^γ × ^Δ است؛ که X و Y به ترتیب هستههای اولیه و نهایی و [−]v معرف آنتی نوترینو است. هسته پسرزن Y باانرژی پسزنی بسیار پایینی تولید میشود؛ که معمولاً پایین تر از آستانه تولید یونش است. تنها ذره یوننده قابل توجهی که در واپاشی بتا تولید میشود، الکترون سریع یا همان ذره بتا است. تفاوت عملی بین الکترون و بتای منفی این است که یک باریکه الکترون باانرژی T متشکل از الکترونهایی است که هریک از آنها

واپاشی میکنند و به اصطلاح چشمههای گسیلنده خالص بتا هستند.[۲] تعدادی از این چشمهها در جدول(۱) به ترتیب از چپ به راست نام ایزوتوپ، نیمه عمر، انرژی بیشینه، انرژی میانگین طیف، انرژی میانگین محاسبه شده و هسته دختر تولیدی نشان داده شده است.[۳]

جدول(۱): تعدادی از چشمههای بتازای خالص [۳].

Isotope	Half-Life	E _{max}	E _{βav}	E _{av}	Daughter Isotope
S-35	87.51 days	167.47 keV	55.8 keV	53.1 keV	Cl – 35
Sr - 90	28.8 years	546 keV	182 keV	167 keV	Y-90
Y-90	2.67 days	2.28 MeV	760 keV	945 keV	Zr-90
Pm-147	2.6 years	224 keV	74.6 keV	61.93 keV	Sm-147
Ni-63	100 years	65.9 keV	22 keV	17 keV	Cu - 63
H-3	12.32 years	18.6 keV	6.2 keV	5.6 keV	He-3

ایزو توپ ^{۱۳}Ni از جمله چشمههای بتازای خالص می باشند؛ که در کاربردهای مختلف به عنوان چشمه گسیلنده الکترون مورداستفاده قرار می گیرند. یکی از کاربردهای سیلیکون استفاده آنها در ساخت قطعات الکترونیکی است. تحلیل و آنالیز انرژی بجا گذاشته ذرات بتا در نیمهرساناها، تخمین عمق نفوذ آنها، در طراحی خاص قطعات الکترونیکی حائز اهمیت است. محققین زیادی از روش های متفاوتی از قبیل معادله برد، روش تحلیلی، روش مونتکارلو و کد MCNPX استفاده کردهاند.[٤] و [٥] کار کمتری روی انرژی کامل طیف بتا انجام شده است. در این پژوهش از کد MCNPX برای مدل جزئیات ترابرد ذرات بتا در سیلیکون استفاده شده است.

۲. روش کار

در این مقاله برای محاسبات و شبیهسازی مونت کارلو از ک.د MCNPX ورژن (۲/۷) استفاده گردیـد. هندسـه شـبیهسـازی

شده مطابق شکل(۱) است. چشمه نقط ای بتازا روی یک سطح مکعب مستطیل در وسط آن قرار داده شده است. چشمه بتازا در ابتدا به صورت جهتی در جهت مثبت محور Z و در مرحله بعد به صورت ایزوتروپیک، برای محاسبات در نظر گرفته شده و در مبدأ مختصات قرار داده شده است. ابعاد سیلیکون مکعب مستطیل شکل، به ابعاد ۵۰۰×۰۰۰ ×۰۰ میکرومتر در نظر گرفته شده است.





ضخامت ۵۰ میکرومتری به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم شده و هر قسمت (سلول) با عرض ۵ میکرومتر و طول و ارتفاع ۰۰۰ میکرومتر میباشد. انرژی بجای گذاشته حاصل از ذرات بتا چشمه نیکل ۲۳ در هر سلول توسط کد محاسبه می گردد. آخرین سلولی که انرژی در آن بهجای نهاده شده است مشخص میشود. از روی آخرین سلول میزان برد الکترون بابا مشخص میشود. از روی آخرین سلول میزان برد الکترون بابا تقریب ۲۰/۰± میکرون بدست می آید. چشمه گسیلنده ذرات بتا در این تحقیق از ایزوتوپ N^{۳۳} با طیف شکل (۲) جهت شبیه سازی در کد مورد استفاده قرار گرفته است. N^۳ دارای انرژی متوسط و ماکزیمم به ترتیب ۱۷/٤ و ۲۷/۹ کیلوالکترون ولت می باشد. [۲]



۳. بحث و نتايج

جهت هم گرایی و اعتمادپذیری نتایج شبیهسازی با کد MCNP و تعیین بهترین تاریخچه با خطای قابلقبول در محاسبات خطای نسبی برای تاریخچه های مختلف و عمق نفوذ (برحسب میکرومتر) محاسبه و نتایج در شکل(٤) نشان داده شده است.



(برحسب ميكرومتر).

مقدار FOM ضریب شایستگی برای تاریخچههای مختلف مطابق شکل(٤) توسط کد محاسبه گردید.



با توجه به شکلهای (۳) و(٤) تاریخچه ^۱۰۷ با خطای قابلقبول مورد پذیرش قرار گرفت؛ و محاسبات کد با این تاریخچه انجام گردید. نتایج بدست آمده عمق نفوذ ذرات بتا در سیلیکون برحسب میکرومتر در جدول(۲) نشان داده شده است.

جدول(٢): نتایج بدست آمده از محاسبات MCNP.

محاسبات	مشخصات چشمه		
MCNP			
0± •/٢0	تک انبرژی باانبرژی متوسط		
	1 <i>V/£</i> KeV		
1"1± •/٢0	تک انىرژى باانىرژى ماكنرىمە	چشمه ۲:	
	77/9 KeV	⁰⁰ INI	
YE/0± •/YO	با طیف تمام انرژی		
	(+- 77/9KeV)		

توان توقف سیلیکون با استفاده از کد ESTAR^۱ به صورت شکل(٥) برای انرژیهای مختلف الکترون محاسبه گردید. محور افقی انرژی برحسب (MeV) و محور عمودی توان توقف برحسب (MeV cm²/gr) میباشد. [۷]



شکل(۵): توان توقف الکترون در سیلیکون با استفاده از کد ESTAR برای انرژیهای مختلف.

¹Stopping Powers and Ranges for Electrons



شکل(۹): انرژی واگذارشده ذرات بتا برای چشمه ایزوتروپیک.

۴. نتیجهگیری

در این پژوهش، طیف انرژی بتای نیکل ۳۳ به صورت طیف کامل انرژی، انرژی متوسط طیف و انرژی ماکزیمم طیف جهت بررسی عمق نفوذ در سیلیکون در نظر گرفته شده است. محاسبات انجام شده به روش مونت کارلو با بهره گیری از کد MCNPX در یک هندسه مشخص انجام گردید. توان توقف الکترونها در سیلیکون با استفاده از کد ESTAR برای انرژیهای مختلف الکترون محاسبه گردید. نمودارهای بدست آمده در بازه انرژی مد نظر توافق خوبی دارند. از روی نمودارها و نتایج بدست آمده تعیین عمق نفوذ به صورت دقیق تری مطابق جدول(۲) انجام گردید. اهمیت این مقاله بیش تر مقالات محاسبات خود را با میانگین انرژی طیف انجام بیش تر مقالات محاسبات خود را با میانگین انرژی طیف انجام دادهاند. نتایج ایس روش در طراحی قطعات نیمههادی سیلیکونی درتهیه آشکارسازها و دزیمترهای هستهای حائز اهمیت است.





شکل(۷): انرژی واگذارشده ذرات بتا با انرژی متوسط ۶۶/۹

کیلوالکترون ولت در ضخامتهای مختلف سیلیکون.



كيلوالكترون ولت در ضخامت هاى مختلف سيليكون.

- M. G. Stamatelatos, T. R. England," Accurate Approximations to Average Beta-Particle Engergies and Spectra", Nucl. Sci. Eng. 63:304,1977.
- [2] Glenn F. Knoll," Radiation Detection and Measurement
 - Fourth Edition" John Wiley & Sons, Inc.2010.
- [3] Sirichai Theirrattanakul, Mark Prelas," A methodology for efficiency optimization of beta voltaic cell design using an isotropic planar source having an energy dependent beta particle distribution", Applied Radiation and Isotopes127, 41-46,2017.
- [4] Tariq R. Alam and Mark A. Pierson, "Principles of Beta voltaic Battery Design", Department of

Mechanical Engineering, Virginia Tech, 439 Goodwin Hall (0238), Blacksburg, VA 24061, USA, 2016.

- [5] Katz, L., Penfold, A., "Range-energy relations for electrons and the determination of beta-ray endpoint energies by absorption". Rev. Mod. Phys. 24 (1), 28.1952.
- [6] Tariq R. Alam, Mark A. Pierson, Mark A. Prelas," Beta particle transport and its impact on beta voltaic battery modeling", Applied Radiation and Isotopes, 130, 80-89, 2017.
- [8]https://www.nist.gov/pml/stopping-power-rangetables-electrons-protons-and-helium-ions

۵. مراجع